

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成26年10月9日(2014.10.9)

【公開番号】特開2013-51340(P2013-51340A)

【公開日】平成25年3月14日(2013.3.14)

【年通号数】公開・登録公報2013-013

【出願番号】特願2011-189231(P2011-189231)

【国際特許分類】

H 0 1 L 33/08 (2010.01)

【F I】

H 0 1 L 33/00 1 2 0

【手続補正書】

【提出日】平成26年8月22日(2014.8.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 8 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 8 2】

絶縁層 1 1 6 は、第 2 クラッド層 1 0 8 上であって、柱状部 1 1 1 の側方（平面視における、柱状部 1 1 1 の周囲）に形成されている。絶縁層 1 1 6 は、柱状部 1 1 1 の側面に接していることができる。絶縁層 1 1 6 の上面は、例えば、コンタクト層 1 1 0 の上面 1 1 5 と連続している。絶縁層 1 1 6 としては、例えば、SiN 層、SiO₂ 層、SiON 層、Al₂O₃ 層、ポリイミド層などを用いることができる。絶縁層 1 1 6 として上記の材料を用いた場合、電極 1 1 2 , 1 1 4 間の電流は、絶縁層 1 1 6 を避けて、該絶縁層 1 1 6 に挟まれた柱状部 1 1 1 を流れることができる。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 9 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 9 5】

なお、発光装置 1 0 0 では、出射部 1 8 1 , 1 8 6 についても I I 族または X I I 族の元素が拡散されることができる。そのため、出射部 1 8 1 , 1 8 6 における C O D 破壊も抑制することができる。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 3 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 3 5】

発光装置 1 0 0 0 では、基板 1 1 0 2 として、GaAs 基板を用いた。第 1 クラッド層 1 1 0 4 として、InGaAlP 層を用いた。活性層 1 1 0 6 として、InGaP ウェル層および InGaAlP バリア層を用いた。第 2 クラッド層 1 1 0 8 として、InGaAlP 層を用いた。コンタクト層 1 1 1 0 として、GaAs 層を用いた。第 1 電極 1 1 1 2 として、Cr 層、AuGe 層、Ni 層、Au 層の順序で積層したものをいい、基板 1 1 0 2 の下面全面に形成した。第 2 電極 1 1 1 4 として、コンタクト層 1 1 1 0 側から Cr 層、AuZn 層、Au 層の順序で積層したものをいい、